コンパクトERLにおけるバンチ圧縮の可能性 に関して

分子科学研究所,UVSOR 島田美帆 日本原子力研究開発機構,JAEA 羽島良一



Outline



- Beam dynamics studies for the 5 GeV ERL
 - 規格化エミッタンス0.1 mm mradを維持する周回部の設計

- Towards user experiment at the compact ERL
 - Short bunch for THz radiation (CSR)
 - 165MeV電子エネルギーにおけるバンチ圧縮
 - Femtosecond X-ray from Laser Compton Scattering
 - 65MeV電子エネルギーにおけるバンチ圧縮



禄文字:トラッキングシミュレーションで使用した初期値



Preservation of low emittance





The emittance growth is minimized when θ_{Phase} coincides with θ_{CSR} (direction of CSR kick).

R. Hajima, Nuclear instruments and Methods in Physics Research A 528 (2004) 335-339 $\tan 2\theta_{Phase} = 2\alpha / (\gamma - \beta)$ $\tan \theta_{CSR} = \sin \phi / \rho (1 - \cos \phi)$ α, β, γ : Twiss parameter, ϕ : bending angle





- 4極磁石の最適化によって、1/5から1/15までエミッタンスを小さくすることが可能。
- 100MeV以上ではほぼ0.1 mm mradを満たしている。
- エミッタンスの最適化によって、若干バンチ長も短くなった。
- エネルギースプレッドも若干小さくなったことを確認した。



Bunch compression

For what the compact ERL can be used?

• Terahertz coherent radiation

- SR of terahertz region, from 1THz to 10 THz, is enhanced by coherent radiation, when the rms electron bunch length is shorter than 1ps.
- Transverse beam size should be less than the wavelength to keep the coherent enhancement -- (un-normalized $\varepsilon_x < 100 \text{ mm mrad}$)



For what the compact ERL can be used?



• Laser Compton Xrays

フェムト秒のX線を発生するにはレーザーとともに、電子バンチもサブピ コ秒の長さを持つ必要がある。

$$E_{x-Ray} \approx 2\gamma^2 E_{Laser}$$
$$\lambda_{Laser} = 800nm \quad (Ti:SaLaser)$$

50keV以下のX線 🛁 電子ビームがおよそ65MeV (7=130)以下

しかし、CSRによる影響は電子エネルギーが小さいほど大きい











optimized by R. Hajima



- *R*₅₆がそれぞれ-0.05から-0.7である周回部において、 *φ*_{RF}と6極磁石を最適化
- *R*₅₆ = -0.1付近がバンチ圧縮には最適

エネルギーによるバンチ圧縮の効果の変 化(77pC, R₅₆ = - 0.1)



- 165MeVの最短バンチ長が65MeVとほぼ同じであるのは、テールの発生が原因。
- テールの形成は電子エネルギーによって非 線形に変化する。
- テールを除くと、エネルギーが大きいほどバンチ圧縮しやすい



165MeVにおけるバンチ圧縮 (テラヘルツ光発生源)





 およそ400pC以下であれば、規格化エミッタンス<100 mm mradかつ バンチ長<0.1psを実現可能である。

65MeVにおけるバンチ圧縮 (Compton散乱によるフェムト秒X線)



- 1nCでは0.6ps程度まで圧縮可能である。しかし、規格化エミッタンスは100mm mradを超えてしまう。
- 0.5 nC以下では容易に0.2ps以下まで短くすることが可能。

まとめ



- バンチ長1ps、低エミッタンスビームの実現
 - 周回部の4極磁石の最適化により、1/5から1/15まで規格化エミッタンスを小さくすることができた。
 - 100MeV以上では、ほぼ0.1 mm mradを数十%の増加程度に抑えることができる。
- バンチ圧縮
 - *R*₅₆の最適化(77pC, 165MeV)
 - バンチ長をできる限り短くするには、R₅₆=-0.1が最適である。
 - エミッタンスの増加も抑える必要がある場合はR₅₆の絶対値を大きくすると効果的である。
 - エネルギーによるバンチ圧縮の効果
 - テールの形成はエネルギーに依存し、その影響は予測困難である。
 - テールを除いた部分のバンチ長はエネルギーが大きいほど短くすることができる。
 - 165MeV電子ビームのバンチ圧縮
 - およそ400pC以下であれば、規格化エミッタンス<100 mm mradかつバンチ長<0.1ps を実現化のである。
 - 65MeV電子ビームのバンチ圧縮
 - 1nCでは0.6ps程度まで圧縮可能である。しかし、規格化エミッタンスは100mm mrad を超えてしまう。
 - 0.5 nC以下では容易に0.2ps以下まで短くすることが可能。